



Horaire	Mercredi 28 Septembre
13:30	Accueil Salle Bonard à l'hôtel Le Saint Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
13:45	Introduction
14:00	Session 1 : Synthèse de Nanofils I (chairman : J. Zuniga-Perez)
14:00 – 14:30	Invité 1 : E. Sarigiannidou, LMGP, « Doping of ZnO nanowires grown by chemical bath deposition: the specific case of Ga investigated by XLD and ab-initio calculations »
14:30 – 14:50	<u>Oral 1</u> : I. Dudko (PhD), INSA Lyon, « Growth and characterization of hexagonal germanium on self-assisted GaAs nanowires by MBE »
14:50 – 15:10	<u>Oral 2</u> : D. Tamsaout (PhD), C2N, « Growth of GaN Nanowires on graphene for flexible light emitting diode »
15:10 – 15:30	<u>Oral 3</u> : F. Bassani, LTM, « Catalyst alloy engineering for enhancing Sn incorporation in vapor-liquid-solid GeSn nanowires »
15:30	Pause-café
16:00	Présentation exposant
16:00 – 16:10	RIBER
16:10 – 16:20	INNODYS – HEIDELBERG INSTRUMENTS NANO
16:20 – 16:30	CAMECA
16:30	Session 2 : Caractérisations et Propriétés I (chairman : J. Eymery)
16:30 – 17:00	Invité 2 : M. Hocevar, NEEL, « Advancing research on nanowire heterostructures with novel characterization tools »
17:00 – 17:20	<u>Oral 4</u> : J. Bosch, CRHEA (PhD), « Etching of the lateral SiGaN Passivation Layer for Full Facet Coverage in InGaN/GaN Core-Shell Nanowires by MOVPE »
17:20 – 17:40	<u>Oral 5</u> : T. Jalabert, IMEP-LAHC, « Probing the local piezoelectric response of semiconducting ZnO nanowires by piezoresponse force microscopy »
17:40 – 18:00	<u>Oral 6</u> : H.-G. Gloriès (PhD), INSA Lyon, « Optical properties of hybrid structures based on ferroelectric polymers and III-V nanowires grown on silicon substrate »
18:00	Fin des présentations



Horaire	Jeudi 29 Septembre
08:50	Accueil Salle Bonard à l'hôtel Le Saint Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
9:00 9:00 – 9:30 9:30 – 9:50 9:50 – 10:10 10:10 – 10:30	Session 3 : Dispositifs pour l'électronique (chairman : S. Plissard) Invité 3 : S. De Franceschi, CEA PHELIQS, « Top-down Si and Ge nanowires for quantum nanoelectronics » <u>Oral 7</u> : E. Dumons (PhD), GREMAN, « Modulation of the electrical conductivity of a ZnO nanowire by surface effects » <u>Oral 8</u> : J. Muller, LAAS, « Advances in top-down fabrication and processing of vertical SiGe nanowire arrays for future nanoelectronics applications » <u>Oral 9</u> : C. Naud, NEEL, « Modulation of the electrical conductivity of a ZnO nanowire by surface effects »
10:30	Session Poster et pause-café
11:00 11:00 – 11:30 11:30 – 11:50 11:50 – 12:10 12:10 – 12:30	Session 4 : Dispositifs pour les applications en Biologie (chairman : B. Alloing) Invité 4 : Y. Coffinier, IEMN, « Silicon based nanowires for the detection of disease biomarkers » <u>Oral 10</u> : I. Muguet (PhD), LAAS, « Optimizing a brain-on-chip technology with nanowire based-3D electrodes to record and stimulate the neuronal activity with high resolution » <u>Oral 11</u> : L. Pichon, IETER, « Capteur à base de nanofils de silicium pour la détection de bactéries Escherichia coli » <u>Oral 12</u> : A. Lecomte, LAAS, « Engineering neuron-nanowire interactions enable control over axonal guidance on wide surfaces »
12:30	Session Poster et repas Buffet dans le Patio
14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 14:50	Session 5 : Synthèse de Nanofils II (chairman : V. Consonni) Invité 5 : A. Trassoudaine, Institut Pascal, « Croissance de nanofils InGaN par HVPE avec des compositions en indium de 0 à 100% » <u>Oral 13</u> : L. Valera (PhD), CEA, IRIG, PHELIQS, NPSC, « Growth of core-shell GaN/Al(Ga)N monolayer system for deep UV emission »

J2N2022 – Programme court



14:50 – 15:10	<u>Oral 14</u> : F. Glas, C2N, « Extended modeling of the group-V-poor regime of III-V nanowire VLS growth »
15:10 – 15:30	<u>Oral 15</u> : E. Chereau (PhD), Institut Pascal, « Croissance selective de nanofils III-As par procédé HVPE »
15:30	Session Poster et pause-café
16:00	Session 6 : Dispositifs pour l’Energie (chairman : V. Sallet) <u>Invité 6</u> : G. Poulin-Vittrant, GREMAN, « ZnO nanowire based piezoelectric generators: principles, challenges and performance "/>
16:00 – 16:30	<u>Oral 16</u> : Y. Leprince, ESYCOM, « ZnO nanostructures for water purification via photocatalysis »
16:30 – 16:50	<u>Oral 17</u> : M. Dietrich (PhD), CEA, IRIG, « CVD grown silicon nanowires, and ALD alumina deposition for ultrastable microsupercapacitor electrodes »
16:50 – 17:10	<u>Oral 18</u> : K. Sekar, GREMAN « Influence of deciding/synthesis parameters of hydrothermally grown ZnO nanowires for FTO - free »
17:30 – 19:00	Convoi vers le diner de gala Ajouter l’adresse
19:00	Diner de Gala



Horaire	Sessions Posters du Jeudi 29 Septembre dans le Patio durant la pause-café et le repas Buffet
10:30 – 11 :00 +	<p><u>P1</u> : V. Sallet, GEMAC, « Epitaxie sélective de nanofils ZnO sur saphir »</p> <p><u>P2</u> : Raphaël C. L-M. DOINEAU, GREMAN, « Impact of bottom electrode and seed layer on the growth of ZnO nanowires for vibrational energy harvesting »</p>
12:30 – 14 :00 +	<p><u>P3</u>: S. Hassani, GEMAC, « Electric and piezoelectric behaviors of ZnO grown by MOCVD »</p>
15:30 – 16 :00	<p><u>P4</u> : V. Consonni, INP, LMGP «Polarity-Dependent Growth and Properties of ZnO Nanorods by Chemical Bath Deposition for Piezoelectric Devices »</p> <p><u>P5</u> : A. Gokarna, L2N, UTT « ZnO nanowires grown on entire silicon wafers via chemical bath deposition: Towards efficient nanowires growth »</p> <p><u>P6</u> : E. Appert, INP, LMPG, «Al and Ga co-doping of ZnO nanowires grown by chemical bath deposition»</p> <p><u>P7</u> : A. Lecestre, LAAS, « Fabrication of III-V vertical nanowires on a standard Si (100) microelectronic substrate »</p> <p><u>P8</u> : Y. Oubaid, NEEL, « Growth and structural characterization of InAs-ZnTe core-shell nanowires »</p> <p><u>P9</u> : L. Rapenne, INP, LMGP, « TEM Characterizations of Epitaxial TiO₂ Shell Grown on ZnO Nanowires by Atomic Layer Deposition cells »</p> <p><u>P10</u> : C. Wei, C2N, « In-Situ TEM Observation of GaAs Nanowire Nucleation on Si »</p> <p><u>P11</u> : G. Bouloz Kossayer, CEA LETI, « Ohmic contact optimization of p-doped GaAs nanowires for infrared detection »</p> <p><u>P12</u> : J. Scola, GEMAC, « Tuning the polymer properties for ZnO-based piezoelectric nano-generator »</p> <p><u>P13</u>: B. Damilano, CRHEA, « Nanolasers et réseaux de nanolasers à base de nanofils de GaN élaborés par sublimation sélective »</p>

J2N2022 – Programme court



Horaire	Vendredi 30 Septembre
08:50	Accueil Salle Bonard à l'hôtel Le Saint Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
9:00	Session 7 : Dispositifs pour l'optoélectronique (chairman : B. Damilano)
9:00 – 9:30	<u>Invité 7</u> : S. Boissier, QUANDELA « Quantum dots in micropillar cavities for quantum light generation : present and future »
9:30 – 9:50	<u>Oral 19</u> : M. Tchernycheva, C2N, « InGaN/GaN nanowire light emitting diodes with an inverted doping order »
9:50 – 10:10	<u>Oral 20</u> : P-M. Coulon, CRHEA, « Towards electrically-injected AlGaIn-based UV core-shell nanorod LEDs »
10:10 – 10:30	<u>Oral 21</u> : K. Kheng, CEA, PHELIQS, « Room temperature single-photon emission of a quantum dot in a tapered nanowire waveguide »
10:30	Pause-café
11:00	Session 8 : Caractérisations et Propriétés II (chairman : M. Tchernycheva)
11:00 – 11:30	<u>Invité 8</u> : F. Panciera, C2N, « Real-time TEM observation of III-V nanowire growth »
11:30 – 11:50	<u>Oral 22</u> : J. Eymery, CEA, IRIG, MEM, NRS, « Serial crystallography and XEOL analysis of nitride wires »
11:50 – 12:10	<u>Oral 23</u> : S. Gomes, CETHIL, « Single nanowire thermal measurement using a STHM-SEM Combined Instrument »
12:10 – 12:30	<u>Oral 24</u> : N. Gogneau, C2N, « Surface Charges effects in GaN NWs: Influence on the electromechanical conversion properties »
12:30	Bilan et discussion collégiale
13:00	Repas Buffet dans le patio
14:00	Réunion du Bureau
16:00	Fin des J2N ☺